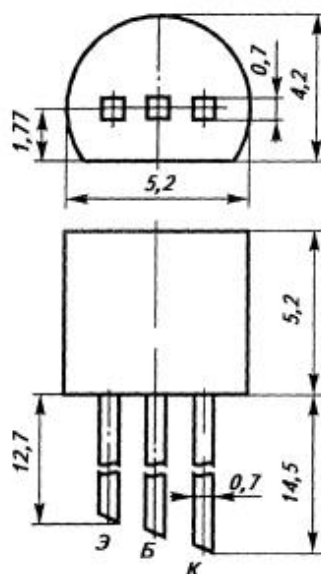


□ КТ681А

Транзистор кремниевый эпитаксиально-планарный структуры *p-n-p* усилительный. Предназначен для применения в усилителях низкой частоты. Выпускается в пластмассовом корпусе с гибкими выводами. На корпус наносится условная маркировка черный квадрат и буква < A >. Масса транзисторов не более 0,3 г



КТ681А

Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ

при $U_{кэ} = 1 \text{ В}$, $I_{к} = 500 \text{ мА}$

$T = +25^\circ\text{C}$

$T = +85^\circ\text{C}$

$T = \pm 45^\circ\text{C}$

при $U_{кэ} = 1 \text{ В}$, $I_{к} = 1 \text{ А}$

при $U_{кэ} = 10 \text{ В}$, $I_{к} = 5 \text{ мА}$,

не менее

типовое значение

85	100*	.300
85	600	
40	.300	
60	.80	
50		
130*		

при $U_{кэ} = 5$ В, $I_{к} = 50$ мА, не менее	80
Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте при $U_{кэ} = 5$ В, $I_{к} = 50$ мА, $f = 100$ МГц	
не менее	1,2
типовое значение	1,5*
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер:	
при $I_{к} = 1$ А, $I_{б} = 0,1$ А	0,27*...0,4*...0,5 В
при $I_{к} = 0,1$ А, $I_{б} = 0,01$ А	0,03*...0,05*...0,2 В
Напряжение насыщения база-эмиттер при $I_{к} = 1$ А, $I_{б} = 0,1$ А	0,9*...0,95*...1,2 В
Обратный ток коллектора при $U_{кб} = 25$ В, не более:	
$T = +25$ и -45°C	10 мкА
$T = +85^{\circ}\text{C}$	500 мкА
Обратный ток эмиттера при $U_{эб} = 5$ В, не более	10 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база	30 В
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер	25 В
Постоянное напряжение база-эмиттер	5 В
Постоянный ток коллектора	0,6 А
Импульсный ток коллектора при $t_{и} = 20$ мс, $Q = 100$	2 А
Постоянный ток базы	0,1 А
Импульсный ток базы при $t_{и} = 20$ мс, $Q = 100$	0,2 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора ¹ при $T < +25^{\circ}\text{C}$	0,35 Вт
Температура p - n перехода	$+125^{\circ}\text{C}$
Тепловое сопротивление переход-среда	$286^{\circ}\text{C}/\text{Вт}$
Температура окружающей среды	$-45...+85^{\circ}\text{C}$

¹ При $T = +25^{\circ}\text{C}$ $P_{к}$, макс снижается линейно на $3,5$ мВт/ $^{\circ}\text{C}$